808nm 10W 高功率边发射单管激光芯片
High Power Single Emitter Diode Laser Chip

性能参数 Performance Parameters	符号 Symbol	典型值 Typical	单位 Unit
Operation			
中心波长 Central Wavelength	λ_c	808	nm
输出功率 Optical Output power	P_{opt}	10	W
工作模式 Operation Mode	-	CW	
Geometric Size			
出光窗口宽度 Emitter Width	W	200	μm
发光点周期 Emitter Pitch	P	500	μm
腔长 Cavity Length	L	4	mm
厚度 Bar Thickness	D	140	μm
Electro Optical Data			
快轴发散角 Fast Axis Divergence (FWHM)	$\theta_{\perp}$	30	Deg
慢轴发散角 Slow Axis Divergence (FWHM)	$\theta_{/\!/}$	＜10	Deg
光谱宽度 Spectral Width (FWHM)	$\triangle\lambda$	＜3	nm
斜率效率 Slope Efficiency	η	1.2	W/A
阈值电流 Threshold Current	I_{th}	1.5	A
工作电流 Operating Current	I_{op}	10	A
工作电压 Operating Voltage	V_{op}	＜2	V
偏振度 Degree of TM Polarization		TE/TM	

备注：1. 本参数为芯片进行封装后，25℃、CW 电流模式下测试结果
These parameters were obtained by testing COS packaged products in the CW mode at 25°C.
2. 避免在结露条件下存储和使用，在超过规定温度下工作会影响寿命
Avoid storage and operation under condensation conditions. Operating above the specified temperature may affect product lifespan.
3. 超过正常功率范围使用会缩短产品使用寿命
Operating beyond the rated power range may shorten the product's service life.

Email：sales@jlight.net.cn Tel：0431-85552059 Website:www.jlight.net.cn